3P140

キトサンの熱分解過程に関する理論的研究

Theoretical Study of Chitosan in Thermal Decomposition Process

([†] 金沢大院・自然、[‡] 東理大) 田村渓一郎[†]、井田朋智[†]、水野元博[†]、遠藤一央[†]、矢島博文[‡] K. Tamura[†], T. Ida[†], M. Mizuno[†], K. Endo[†], H. Yajima[‡]

[†]Graduate School of Natural Science & Technology, Kanazawa University

[‡]Dept. of Applied Chemistry, Fac. of Science Division 1, Tokyo University of Science

[序]

キトサンは天然由来の安定な生体高分子であり、環境にやさしく人体に無害であることから、様々な分野への 応用がなされている。その例としては再生医療材料や繊維などがあるが、工業的な応用には耐侵食性、耐摩耗 性の改良が必要であり、イオンビーム照射によって表面改質が行われている。加えて近年では生体内に高分子 材料を埋め込む際、生体との融和性を高めるためにもイオンビーム照射が行われている。しかしキトサン表面 でどのような構造の変化が起こっているのかはまだ解っていない。

我々はすでにキトサンの Kr⁺ イオンビーム照射前後の XPS を測定し、キトサン表面の元素比率の変化につい て実験的に解析した。本研究ではイオンビーム照射によりキトサン表面で熱分解反応が起こっていると考え、 DFT 計算による結合次数解析から熱分解後の構造を予測し、初期構造と熱分解後の構造を用い内殻及び価電 子帯 XPS をシミュレーションし、キトサン表面の変化の理論的な解明を目的としている。



図1 キトサンの構造

[計算方法]

キトサンの二量体をモデル分子とし、ADF(Amsterdam Density Functional)program¹ を用い構造最適化し た後、Nalewajski-Mrozek 法² を用いた結合次数計算から熱分解後の構造を予測した。初期構造と予測し た熱分解後の構造を基に CEBE(Core electron Binding Energy) 及び価電子帯の VIP(Vertical Ionization Potential) を計算した。構造最適化と CEBE は交換相関ポテンシャル PW86/PW91 を用い、Δ*E*_{KS} 法によ り計算を行った。WD は各原子の実験値と計算値の差を取りその平均値とした。

 $E_{\rm CEBE} = E_{\rm CH} - E_{\rm GS}$

CH : excited core hole state, GS : ground state

結合次数と価電子帯の VIP のは交換相関ポテンシャル SAOP(Statistical Average of Orbital Potential) 法 を用い、Koopmans-like 法により計算を行った。基底関数は全て TZP を用いた。価電子帯 XPS の強度は Gelius Intensity Model³ に基づき Al $K\alpha$ 照射における相対光イオン化断面積 (Yeh の理論値⁴)を乗じて算 出した。

$$I_i \sim \sum_A \sum_{p(A)} \mid C_{ip} \mid^2 \sigma_{p(A)}$$

ここで C_{ip} は i 番目の KS 軌道の LCAO 係数であり、 $\sigma_{p(A)}$ は相対光イオン化断面積である。スペクトルシ ミュレーションは各輝線スペクトルに対して Gauss 型分布関数の重ね合わせとしその線幅は内殻では 1.5eV、 価電子帯では VIP の 10 %とした。

$$WH(k) = 0.10 I_k$$



図 2 固体ポリマーと気体モデル分子のエネルギー準 位の関係

表 相対光イオン化断面積

Atomic	Orbital	Relative Photo-Ionized
		Cross Section
С	2s	1.0000
	2p	0.0323
Ν	2s	1.7925
	2p	0.1364
Ο	2s	2.8602
	2p	0.3910

[結果]

結合次数解析の結果、熱分解過程は数パターン考えられその一例を示す。熱分解はまず水素原子の飛散が起こ りその後に置換基の飛散、糖鎖の開裂が起こると考えられた。初期構造と結合次数解析で得られた最終構造を 基に行った XPS シミュレーションでは熱分解前後ともに実測スペクトルをよく再現しており、ピークの帰属 を行うことができた。WD は 5.6eV と見積もった。スペクトルの変化の主な要因は置換基の飛散と二重結合 の増加であることが解った。発表当日は他の分解パターン、内殻スペクトルについても詳しく報告する。



図4 価電子帯の実測スペクトルとシミュレーションスペクトルの比較(左;初期構造、右;最終構造)

 $^{^1\}mathrm{ADF}$ Program System, Release 2002/2003, Scientific Computing & Modeling, NV, Amsterdam (2000).

 $^{^2\}mathrm{R.}$ F. Nalewajski, J. Mrozek, International Journal of Quantum Chemistry, 61, p589 (1997).

³U. Gelius, K. Siegbahn, Faraday Discus. Chem. Soc. 54, 257 (1972).

⁴J. -J. Yeh, Atomic Calculation of Photoionization Cross-Section and Asymmetry Parameters, Gordon and Breach Science Publishers (1993).